

① Int.Cl.²
H 05 B 33/12

② 日本分類
99(5) K 0

③ 日本国特許庁
公開実用新案公報

庁内整理番号 7437-54

④ 実開昭52-9366

⑤ 公開 昭52(1977). 1.22

審査請求 未請求

⑥ 電気ルミネセンス素子

⑦ 発 願 昭50-94938

⑧ 出 願 昭50(1975) 7月8日

⑨ 考 案 者 日紫喜哲雄

名古屋市瑞穂区高辻町14の18

日本特殊陶業株式会社内

同 八木秀明

同所

⑩ 出 願 人 日本特殊陶業株式会社

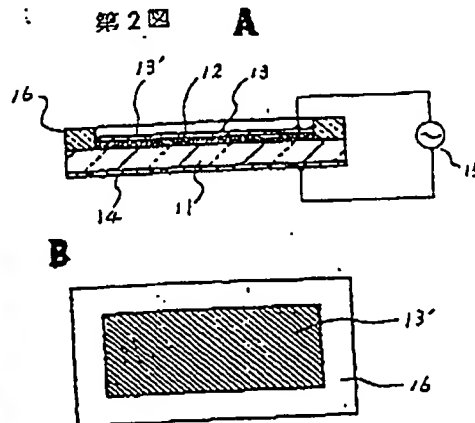
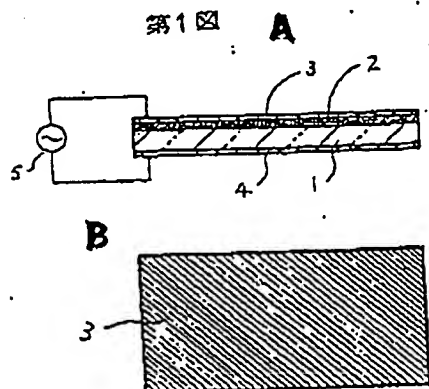
名古屋市瑞穂区高辻町14の18

⑪ 実用新案登録請求の範囲

強誘電セラミツク材料よりなる基板の上面に蛍光層と一方の透明電極層を、下面には他方の電極層のみを直接、又は蛍光層と他方の電極層を各々被層形成してなる電気ルミネセンス素子において、

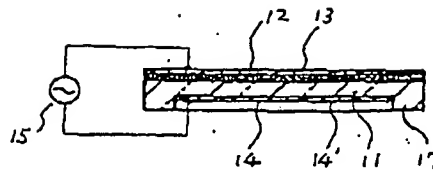
前記基板の上下面のいずれか片面又は両面の外周部に、前記電極層を内側に埋嵌するバリヤ絶縁壁を設けたことを特徴とする電気ルミネセンス素子。
図面の簡単な説明

第1図は本案を説明するために掲げた本案実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその上面図である。第2図は本案の一実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその上面図、第3図は本案の他の実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその下面図、第4図は前記第3図実施例に使用される圧刻装置の概略図を示す。
1, 1'.....セラミツク基板、2, 12.....蛍光層、3, 13, 13'.....一方の透明電極層、4, 14, 14'.....他方の電極層、16, 17.....バリヤ絶縁壁。

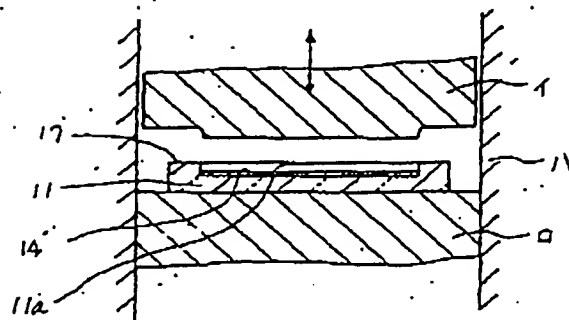


突開 昭52-9366(2)

第3図



第4図



#8. Unexamined Utility Model Publication**Sho52-9366**

54. Electro-luminescence Device

72. Inventors:

Hishiki, Tetsuo and Yagi, Hideaki

71. Applicant:

Nihon Tokushu Togyo, Nagoya

43. Date of Publication:

January 22, 1977

21. Application Number:

50-94938

22. Application Date

July 8, 1975

57. Area of Claims

With electro-luminescence device, which has fluorescent layer and one transparent electrode layer are formed on top side of strong dielectric ceramic substrate, and other electrode layer only is formed directly or luminescence layer and other electrode layers are formed on bottom side of substrate, device is characterized by the fact that barrier insulator wall to enclose electrode layer is formed either on one side or on both sides of substrate.

Brief Explanation of Figures

Figure 1 is shown to explain electro-luminescence device of the utility model. A is front cross section, and B is top plan view. Figure 2 shows application example of electro-luminescence device of this utility model. A is front cross sectional view and B is top plan view. Figure 3 shows another application example of electro-luminescence device of this utility model. A is front cross sectional view and B is bottom plan view. Figure 4 is simplified view of device structure used in application of Fig. 3.

1, 11' ...	ceramic substrate,
2, 12' ...	luminescence layer,
3, 13, 13' ...	transparent electrode layer of one side,
4, 14, 14' ...	electrode layer of other side,
16, 17 ...	barrier insulator wall

⑤ Int.Cl.²
H 05 B 33/12

⑥ 日本分類
99(5) K 0

⑦ 日本国特許庁

公開実用新案公報

⑧ 実開昭52-9366

⑨ 公開 昭 52(1977). 1.22

庁内整理番号 7437-54

審査請求 未請求

⑩ 電気ルミネセンス素子

⑪ 実 願 昭 50-94938

⑫ 出 願 昭 50 (1975) 7月8日

⑬ 考 案 者 日 紫 喜 哲 雄

名古屋市瑞穂区高辻町14の18

日本特殊陶業株式会社内

同 八木秀明

同所

⑭ 出 願 人 日本特殊陶業株式会社

名古屋市瑞穂区高辻町14の18

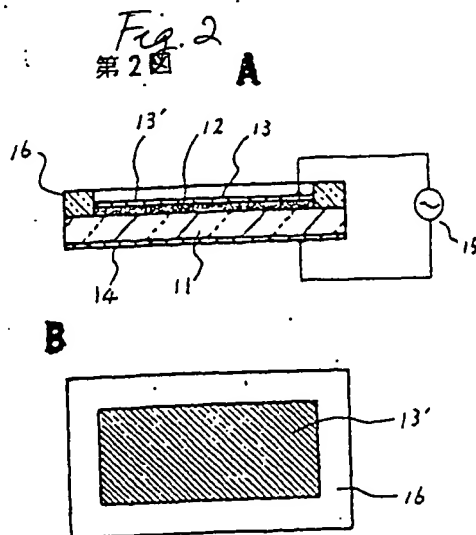
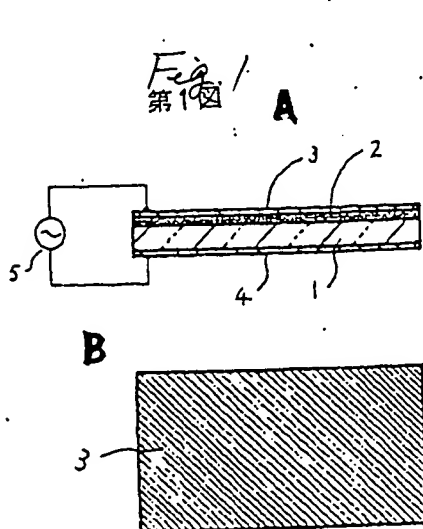
⑮ 実用新案登録請求の範囲

強誘電セラミック材料よりなる基板の上面に蛍光層と一方の透明電極層を、下面には他方の電極層のみを直接、又は蛍光層と他方の電極層を各々被着形成してなる電気ルミネセンス素子において、

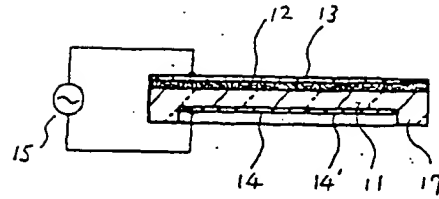
前記基板の上下面のいずれか片面又は両面の外周部に、前記電極層を内側に囲繞するバリヤ絶縁壁を設けたことを特徴とする電気ルミネセンス素子。
図面の簡単な説明

第1図は本案を説明するために掲げた参案実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその上面図である。第2図は本案の一実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその上面図、第3図は本案の他の実施例に係る電気ルミネセンス素子を示し、Aは断面正面図、Bはその下面図、第4図は前記第3図実施例に使用される圧刻装置の概略図を示す。

1, 11'……セラミック基板、2, 12'……蛍光層、3, 13, 13'……一方の透明電極層、4, 14, 14'……他方の電極層、16, 17……バリヤ絶縁壁。



第3図 Fig. 3



第4図 Fig. 4

